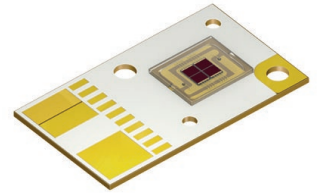


LE A P2W

OSRAM OSTAR® Projection Power

欧司朗 OSTAR Projection Power 是一款用于投影应用的高亮度 LED。



应用

— 专业投影 (LED & 激光)

— 家用投影 (LED & 激光)

特点:

- 封装: 用于投影仪的高功率 OSTAR
- 芯片技术: Thinfilm
- 典型辐射值: 120° (朗伯发射极)
- 颜色: $\lambda_{\text{dom}} = 617 \text{ nm}$ (• amber)
- 防腐蚀级别: 3B
- ESD: 2 千伏 按照 ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)

订购信息

型号	Luminous Flux ¹⁾ $I_F = 24000 \text{ mA}$ Φ_V	订单码
LE A P2W-SUTR-23	2590 ... 3590 lm	Q65112A7738

最大额定

参数	图形符号		值
Operating Temperature	T_{op}	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Storage Temperature	T_{stg}	min.	-40 °C
		max.	100 °C
Junction Temperature	T_j	max.	125 °C
Forward Current $T_j = 125\text{ °C}$; all chips operated in parallel	I_F	min.	400 mA
		max.	20000 mA
Forward Current pulsed $D = 0.25$; $f = 240\text{ Hz}$; $T_j = 25\text{ °C}$; all chips operated in parallel	$I_{F\ pulse}$		24000 mA
Surge Current $t_p \leq 10\ \mu\text{s}$; $D = 0.1$; $T_j = 125\text{ °C}$; all chips operated in parallel	I_{FS}	max.	32000 mA
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V_{ESD}		2 kV
Reverse current ²⁾	I_R	max.	200 mA

特性

$T_{\text{Board}} = 25\text{ °C}$; $I_F = 24000\text{ mA}$; $f = 1000\text{ Hz}$; $t_{\text{int}} = 100\text{ ms}$; $D = 0.25$; all chips operated in parallel

参数	图形符号		值
Peak Wavelength	λ_{peak}	typ.	624 nm
Dominant Wavelength ³⁾	λ_{dom}	min.	612 nm
		typ.	617 nm
		max.	624 nm
Spectral bandwidth at 50% $I_{\text{rel,max}}$	$\Delta\lambda$	typ.	18 nm
Viewing angle at 50% I_V	2ϕ	typ.	120 °
Radiating surface	A_{color}	typ.	2.6 x 3.2 mm ²
Partial Flux acc. CIE 127:2007 ⁴⁾ $I_F = 24000\text{ mA}$	$\Phi_{\text{EV}, 120^\circ}$	typ.	0.82
Forward Voltage ⁵⁾ $I_F = 24000\text{ mA}$; all chips operated in parallel	V_F	min.	2.80 V
		typ.	3.00 V
		max.	4.00 V
Deviation of forward voltage of all chips	V_F	max.	135 mV
Reverse voltage (ESD device)	V_{RESD}	min.	45 V
Reverse voltage ²⁾ $I_R = 20\text{ mA}$	V_R	max.	1.2 V
Real thermal resistance junction/board ⁶⁾	$R_{\text{thJB real}}$	typ.	0.6
		max.	0.7
Electrical thermal resistance junction/board ⁶⁾ with efficiency $\eta_e = 13\%$	$R_{\text{thJB elec.}}$	typ.	0.52
		max.	0.61

亮度组

组	Luminous Flux ¹⁾ $I_F = 24000 \text{ mA}$ min. Φ_V	Luminous Flux ¹⁾ $I_F = 24000 \text{ mA}$ max. Φ_V
SU	2590 lm	2800 lm
TP	2800 lm	3040 lm
TQ	3040 lm	3300 lm
TR	3300 lm	3590 lm

波长组

组	Dominant Wavelength ³⁾ min. λ_{dom}	Dominant Wavelength ³⁾ max. λ_{dom}
2	612 nm	618 nm
3	618 nm	624 nm

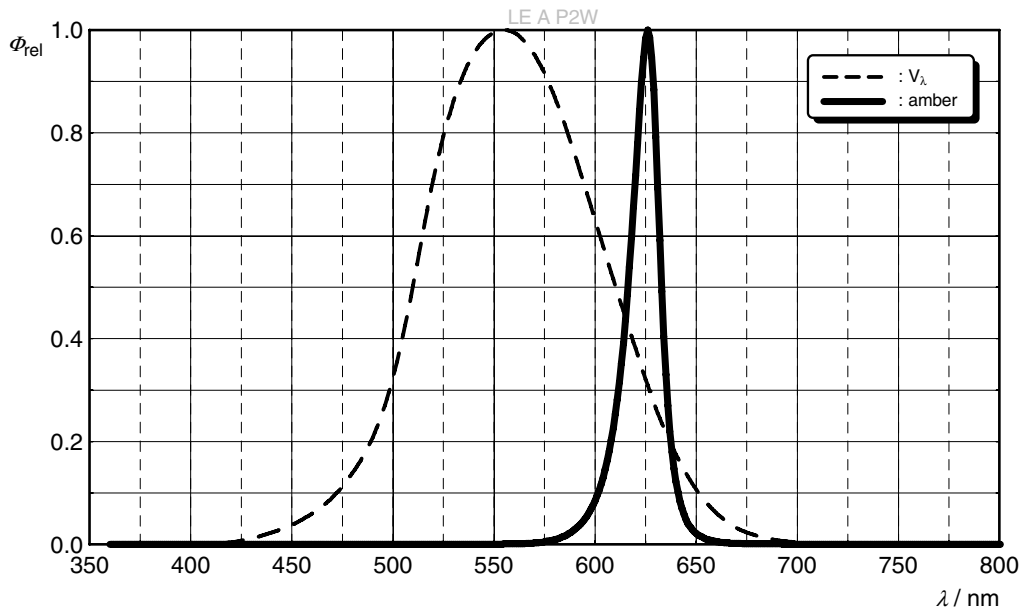
标签信息

示例: SU-2

亮度组	波长
SU	2

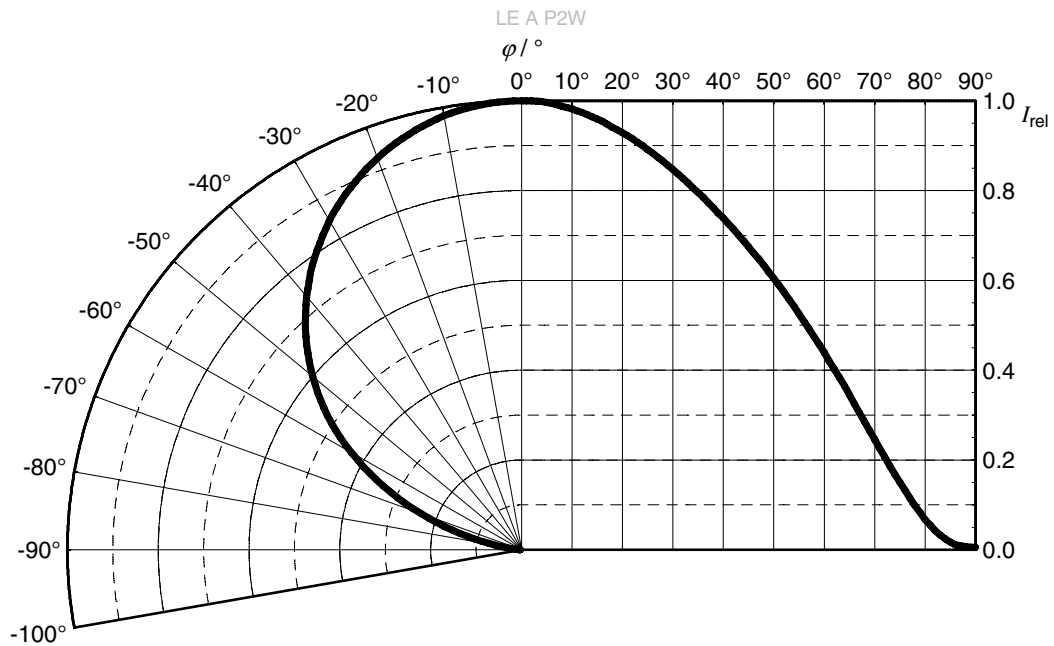
相对光谱发射 4)

$\Phi_{rel} = f(\lambda)$; $I_F = 24000 \text{ mA}$; $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$; all chips operated in parallel



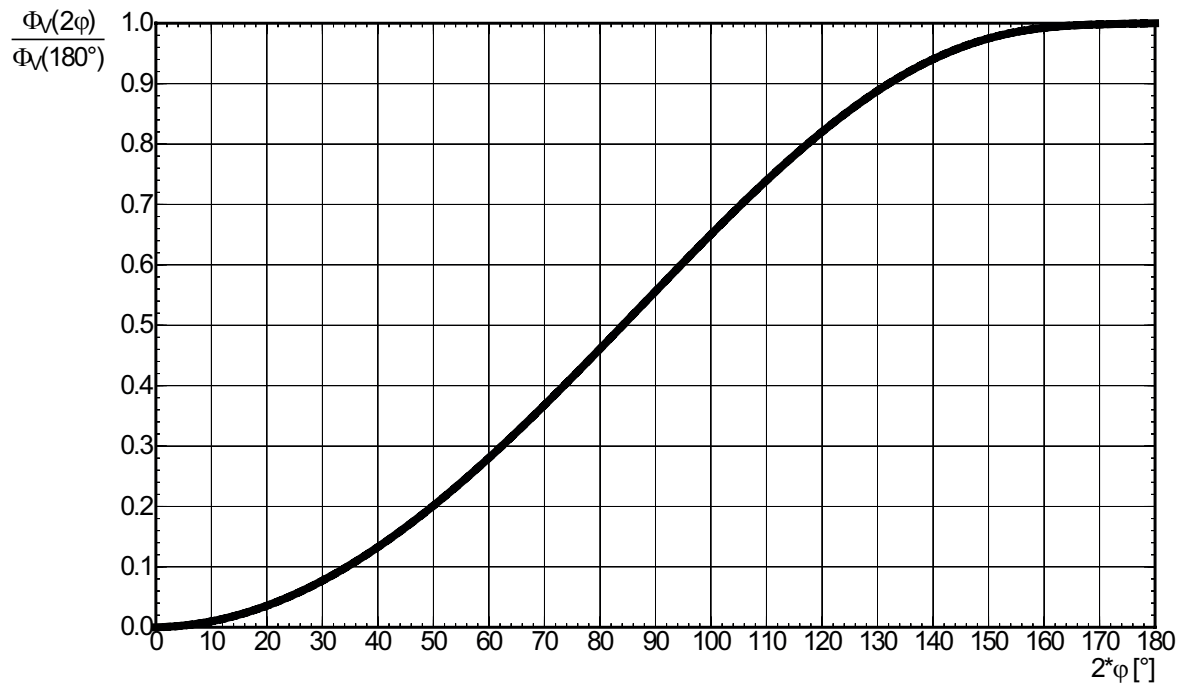
辐射特性 4)

$I_{rel} = f(\phi)$; $T_J = 25 \text{ }^\circ\text{C}$



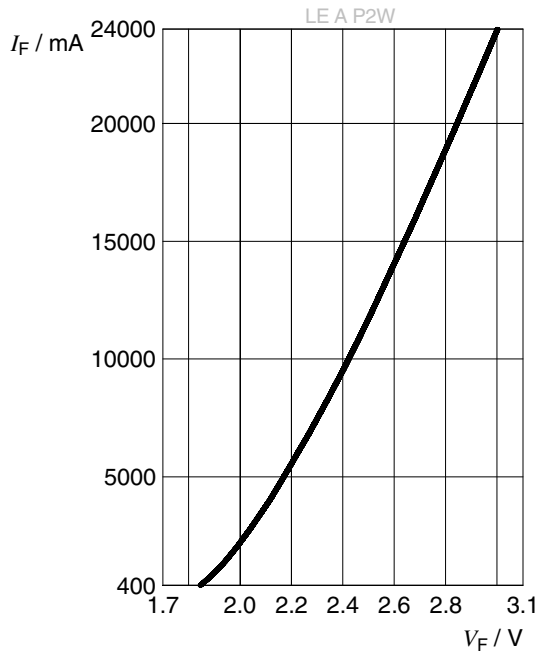
相对部分光通量 ⁴⁾

$$\Phi_v(2\varphi)/\Phi_v(180^\circ) = f(\varphi); T_j = 25^\circ\text{C}$$



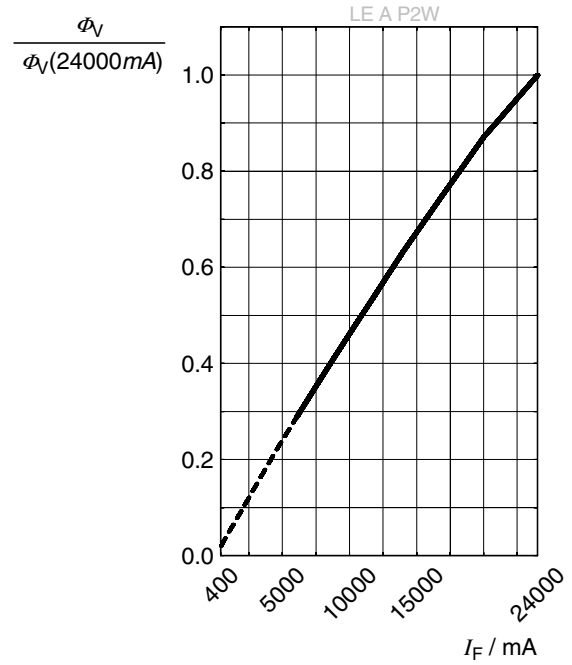
正向电流 4), 7)

$I_F = f(V_F)$; $T_J = 25\text{ °C}$;
all chips operated in parallel



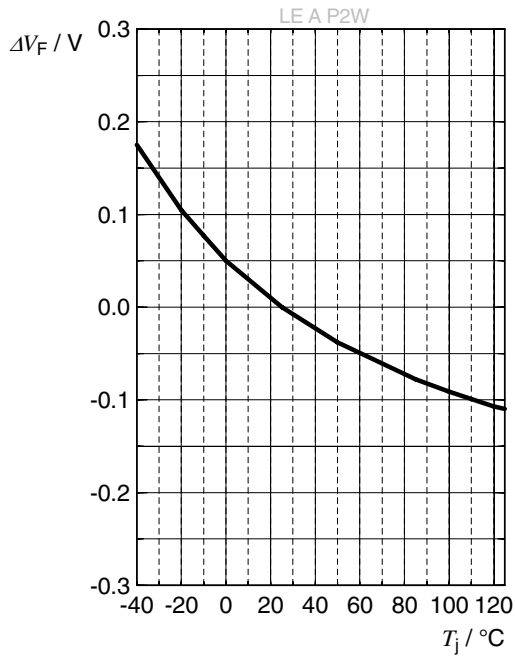
相对光通量 4), 7)

$\Phi_V / \Phi_V(24000\text{ mA}) = f(I_F)$; $T_J = 25\text{ °C}$;
all chips operated in parallel



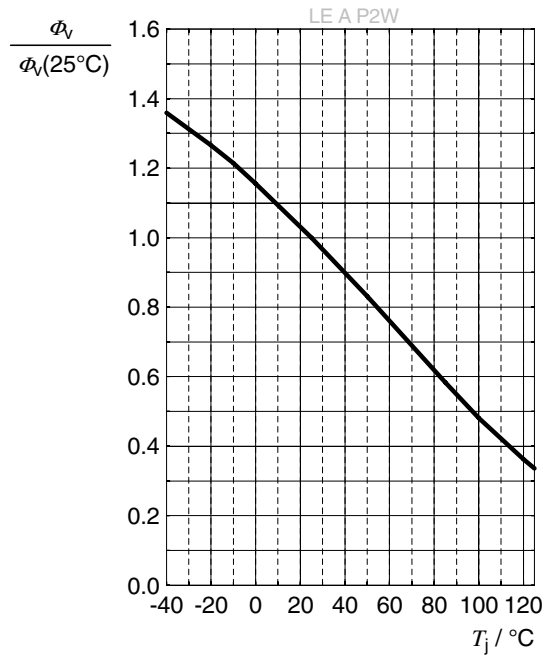
正向电压 4)

$\Delta V_F = V_F - V_F(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 24000\text{ mA};$
all chips operated in parallel



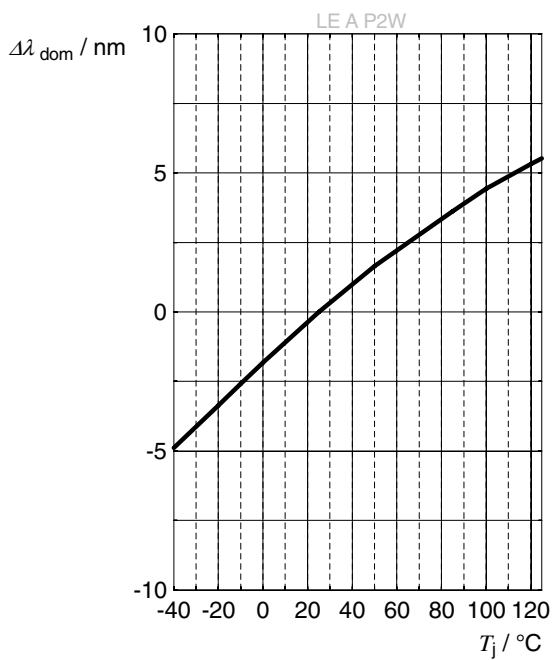
相对光通量 4)

$\Phi_V / \Phi_V(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 24000\text{ mA};$
all chips operated in parallel

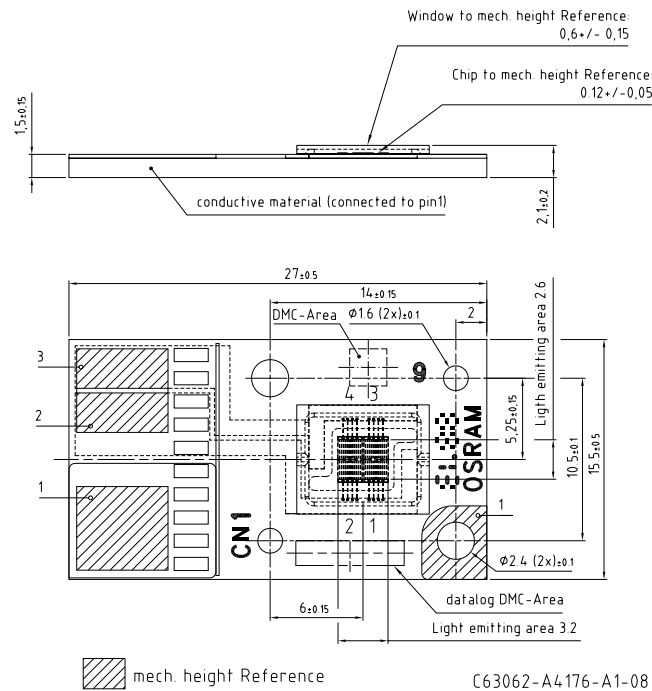


主波长 4)

$\Delta \lambda_{\text{dom}} = \lambda_{\text{dom}} - \lambda_{\text{dom}}(25\text{ }^\circ\text{C}) = f(T_j); I_F = 24000\text{ mA};$
all chips operated in parallel



尺寸图 8)



备注:

近似重量:

5,000.0 mg

腐蚀试验:

类别: 3B

测试条件: 40°C / 90 % RH / 15 ppm H₂S / 14 days (stricter than IEC 60068-2-43)

ESD建议:

该产品由与芯片并联的ESD防护器件提供保护。

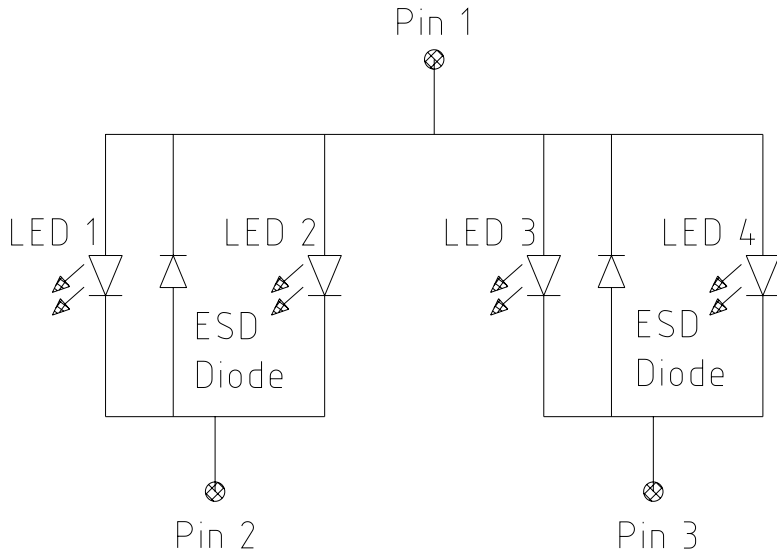
标注:

封装不适合任何湿式清洗或超声波清洗

接插件:

Recommended connector: TARNG YU ENTERPRISE CO.,LTD / TA8051W-NR-02S-A / PO: 4510445465

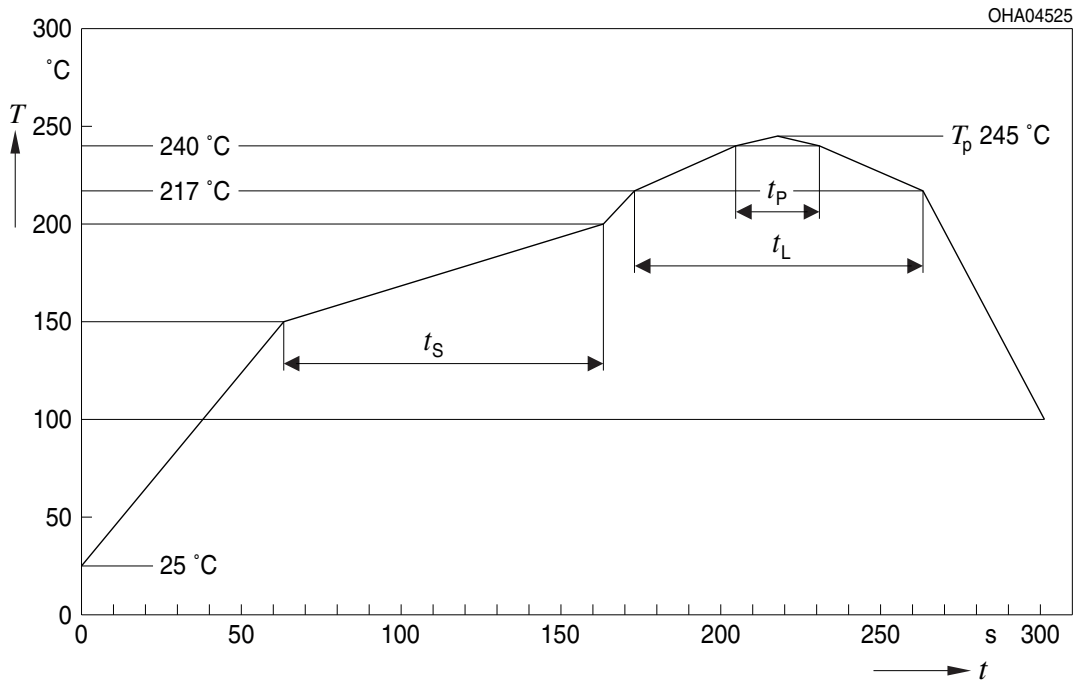
内部电子电路



- 1: anode
- 2: cathode LED 1 and 2
- 3: cathode LED 3 and 4

回流焊曲线

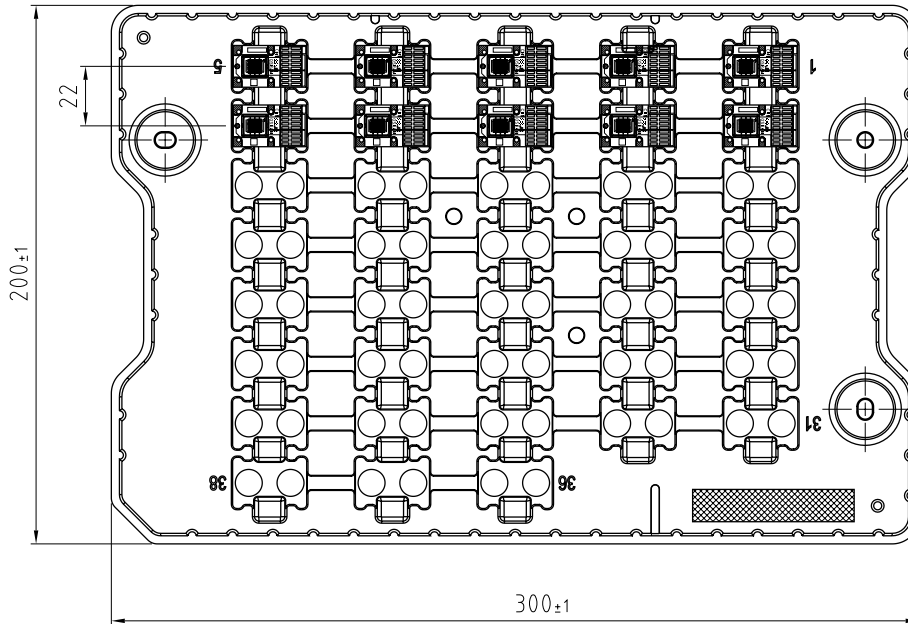
产品符合MSL等级 2 根据JEDEC J-STD-020E



曲线特征	符号	无铅组装			单位
		最小值	推荐值	最大值	
预热升温速率 ¹⁾ 25 °C 至 150 °C			2	3	K/s
时间 t_s T_{Smin} 至 T_{Smax}	t_s	60	100	120	s
峰值升温速率 ¹⁾ T_{Smax} 至 T_p			2	3	K/s
液相线温度	T_L		217		°C
超过液相线温度的时间	t_L		80	100	s
峰值温度	T_p		245	260	°C
温度保持在指定峰值温度 $T_p - 5 K$ 的 5 °C 范围内的时间	t_p	10	20	30	s
降温速度* T_p 至 100 °C			3	6	K/s
时间 25 °C 至 T_p				480	s

所有温度均指从元件顶部测得的封装中心温度
 * 斜率计算 DT/Dt : Dt 最大值为 5 s; 涵盖整个 T 范围

编带机 8)



C63062-A4389-B10-01

条形码-产品-标签 (BPL)

OSRAM Opto Semiconductors LX XXXX BIN1: XX-XX-X-XXX-X

RoHS Compliant






(6P) BATCH NO: 1234567890

(9D) D/C: 1234

(X) PROD NO: 123456789 (Q) QTY: 9999 (G) GROUP: XX-XX-X-X

ML Temp ST
X XXX °C X

Pack: RXX
DEMY XXX
X_X123_1234.1234 X

OHA04563



条形码-托盘-标签 (BTL)

LE xxx xxx Group: xxxx-xxxx-xxxx

Data Matrix Code

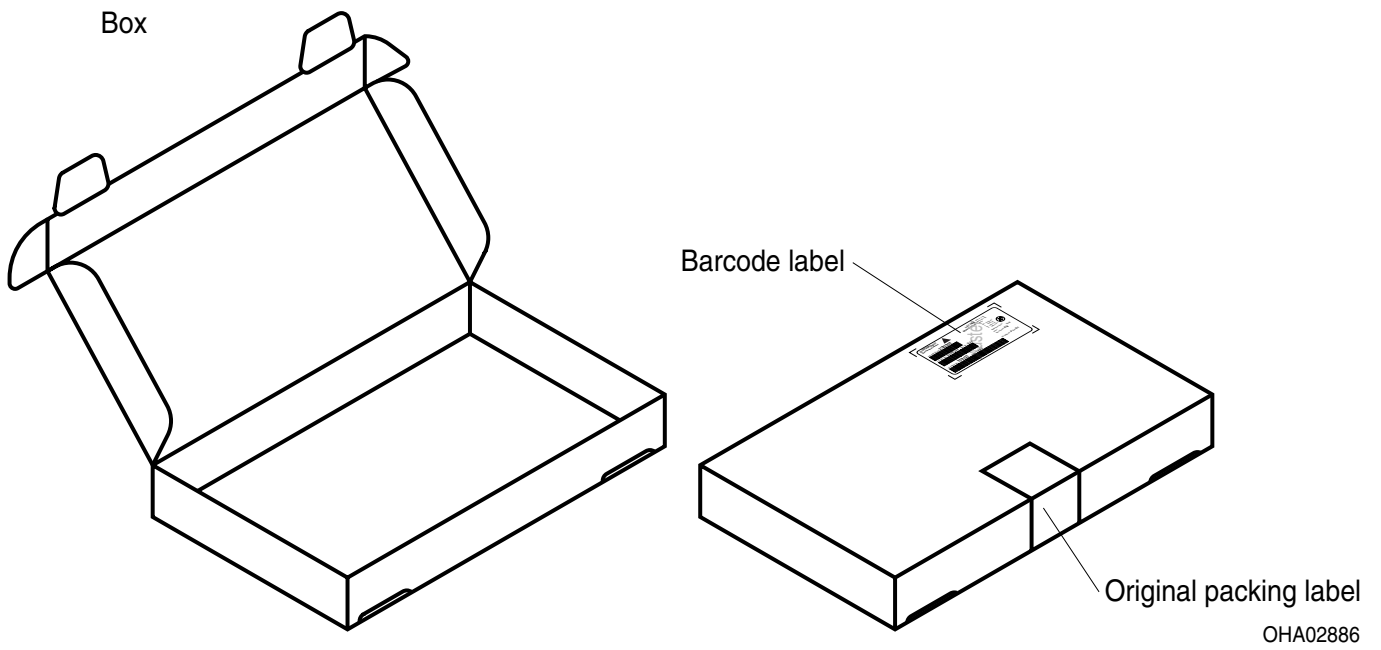
xxxx BIN

MATERIAL: Material Number Batch Batch Number BIN: xxxx

OHA02684_1

运输箱示意图 ⁸⁾



运输箱尺寸

宽度	长度	高度
333 ± 5 mm	218 ± 5 mm	28 ± 5 mm
337 ± 5 mm	218 ± 5 mm	63 ± 5 mm

Type Designation System



Data Matrix Code Description

The Data Matrix Code bin information is Laser marked during testing

Content: aaaa@bbbb@ccc@dddd@eeee

Data Matrix Code Type: ECC200

a = Luminous Flux (Phiv) [lm] or Radiant Flux (Phie) [W]	(example: 3306)
b = Forward Voltage (Vf) [V]	(example: 3.46)
c = Wavelength (Ldom) [nm]	(example: 618)
d = Color Coordinate Cx	(example: 0.321)
e = Color Coordinate Cy	(example: 0.641)
@: Seperator = Blank	

备注

人眼安全的评估按照IEC 62471:2008标准(photo biological safety of lamps and lamp systems)进行。在本CIE标准的风险分组系统中，本数据表中指定的LED属于该类 **豁免等级 (暴露时间 10000 s)**。在某些情况下(如不同的暴露时间、瞳孔大小、观察距离等)，尽管这些产品对人眼没有危害。但是理论上来说，由于强光光源的致盲作用，它们具有很高的二次曝光可能性。例如当注视其他明亮的光源(如前照灯)时，也会出现视力暂时下降和余像情况，也可能会导致不同程度的急躁、恼怒、视力受损等情形。

除其他物质外，该器件的子组件还包含金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含残留侵蚀性物质的环境的影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量少将器件暴露于腐蚀性物质环境中。当使用上述测试条件进行测试时，器件在规定的测试持续时间内表现出了颜色的变化，但其各项性能的变化均未超出失效极限的定义。IEC60810中描述了相关的各项失效极限。

更多的应用信息，请访问 www.osram-os.com/appnotes

免责声明

语言

如中、英文文本描述有任何差异或偏差，以英文文本为准。

The English version of this document will prevail in case of any discrepancies or deviations between the Chinese and English document.

请注意!

该信息仅描述了组件的类型，不能视为对组件特征的保证。本公司保留对交付条款和设计更改的权利。由于技术要求，组件可能含有危险物质。

如需咨询相关类型的信息，请联系我们的销售组织。

如需打印或下载，请自行在欧司朗光电半导体网站上寻找最新版本。

包装

请使用您所知的回收操作员。我们亦可帮助您与离您最近的销售办事处联系。

若双方另行存在协议，在您事先对包装材料已进行分类的前提下，我们亦可回收包装材料，但贵方必须承担运输费用。对于退回给我们的包装材料，若未事先分类或我司并无义务接收的，我们将向您收取相关回收费用并开具发票。

产品安全设备/应用或医疗设备/应用

欧司朗光电半导体组件并非开发、构建或测试用作安全相关组件或应用于医疗设备，亦不适格适合在该等设备的模组或系统层面使用。

如果买方或买方供货的终端客户考虑在产品安全设备/应用或医疗设备/应用中使用的欧司朗光电半导体组件的，买方和/或客户必须立即通知欧司朗光电半导体的当地销售伙伴，由欧司朗光电半导体和买方和/或客户将就客户的特定需求进行分析和协调。

词汇表

- 1) **亮度:** 亮度值通常在100 ms脉冲序列期间测量，脉冲宽度为250 μ s，频率为1 kHz，内部再现性为 $\pm 8\%$ ，扩展不确定度为 $\pm 11\%$ （依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。峰值亮度根据脉冲持续时间和频率计算。
- 2) **反向工作:** 应在规定的范围内，对本产品施加正向电流。应避免施加任何在规定的可发光的电压范围之外的连续反向或正向电流电压，因为这可能会引起迁移，从而改变电光特性或损坏LED。
- 3) **波长:** 波长通常在100 ms脉冲序列期间测量，脉冲宽度为250 μ s，频率为1 kHz，内部再现性为 ± 0.5 nm，扩展不确定度为 ± 1 nm（依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 4) **典型值:** 由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算相关性只能反映统计数字。这些参数不一定对应每个产品的实际参数，可能不同于产品的典型数据和计算相关性或典型特性线。如有要求（例如由于技术改进），这些典型数据会被更改，恕不另行通知。
- 5) **正向电压:** 正向电压通常在250 μ s脉冲期间测量，内部再现性为 ± 0.05 V，扩展不确定度为 ± 0.1 V（依据包含因子 $k=3$ 的不确定度测量）。
- 6) **热电阻:** $R_{th\ max}$ 以统计值（ 6σ ）为基础。
- 7) **特性曲线:** 如图形线段断开，即可预期同一封装单元内的单个器件之间的差异会较大。
- 8) **测量公差:** 除非图纸中另有说明，公差表示为 ± 0.1 ，尺寸表示为mm。

修订历史

版本	日期	修改
1.9	2018-11-28	订货办法 特性 光电特性 (图表) 新布局
1.10	2019-09-05	托盘
1.11	2020-06-30	不推荐新设计使用
1.12	2020-10-13	已停产

Published by OSRAM Opto Semiconductors GmbH EU RoHS and China RoHS compliant product
Leibnizstraße 4, D-93055 Regensburg
www.osram-os.com © All Rights Reserved.



此产品符合欧盟 RoHS 指令的要求；
按照中国的相关法规和标准，不含有毒有害物质或元素。

单击下面可查看定价，库存，交付和生命周期等信息

[>>OSRAM\(欧司朗光电半导体\)](#)